



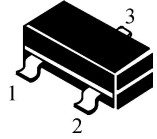
安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

2SC3356

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極發射極電壓	V_{CEO}	12	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極基極電壓	V_{CBO}	20	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓	V_{EBO}	3.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I_c	100	mAdc

■ THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) $T_A=25^{\circ}C$ 環境溫度為 $25^{\circ}C$ Derate above $25^{\circ}C$ 超過 $25^{\circ}C$ 遞減	P_D	225 1.8	mW mW/ $^{\circ}C$
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2) $T_A=25^{\circ}C$ Derate above $25^{\circ}C$ 超過 $25^{\circ}C$ 遞減	P_D	300 2.4	mW mW/ $^{\circ}C$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	417	$^{\circ}C/W$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	-55to+150 $^{\circ}C$	

■ DEVICE MARKING 打標

2SC3356=R25

H_{FE}:125-250



2SC3356

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

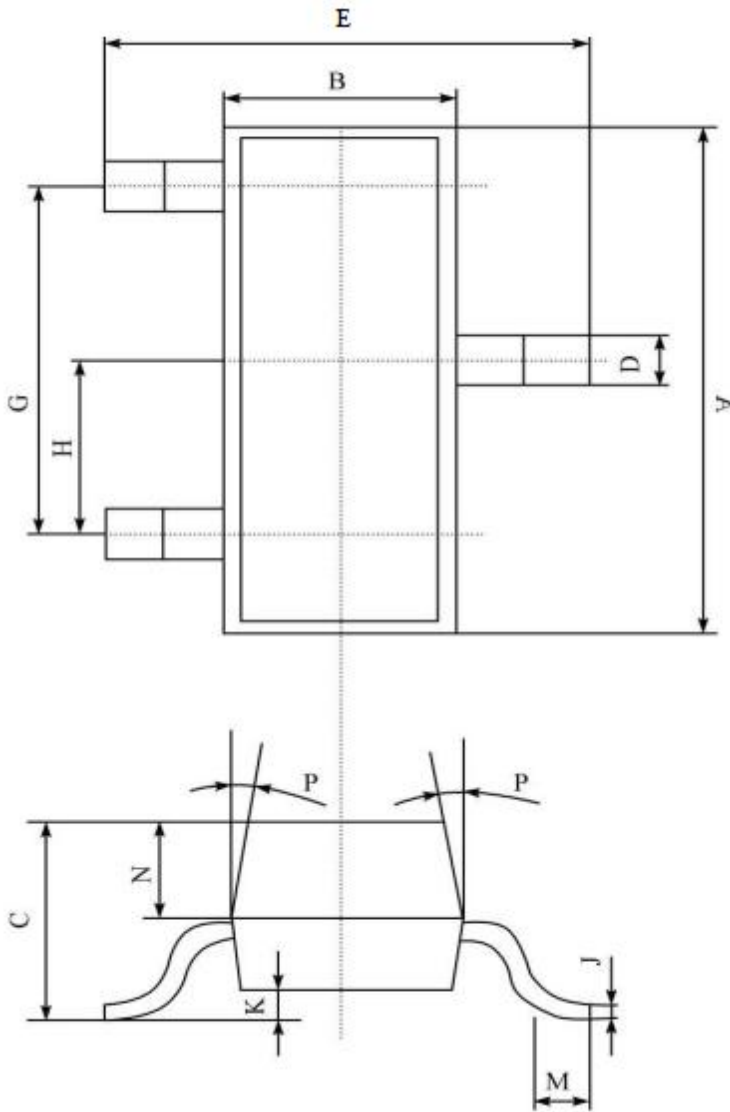
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流($V_{EB}=1.0\text{v}, I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	1.0	μA
Collector Cutoff Current 集電極截止電流($V_{CB}=10\text{v}, I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	1.0	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極基極擊穿電壓($I_C=10\mu\text{A}$)	$V_{(BR)CBO}$	20	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極發射極擊穿電壓($I_C=1\text{mA}$)	$V_{(BR)CEO}$	12	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極基極擊穿電壓($I_E=10\mu\text{A}$)	$V_{(BR)EBO}$	3	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益 ($V_{CE}=10\text{v}, I_C=20\text{mA}$)	H_{FE}	50	—	300	
Gain Bandwidth Product 增益帶寬乘積($V_{CE}=10\text{v}, I_C=20\text{mA}$)	f_T	—	7000	—	MHz
Noise Figure 噪声係數 ($V_{CE}=10\text{V}, I_C=7\text{mA}, f=1.0\text{GHz}$)	NF	—	—	2.0	dB
Feed-Back Capacitance 反饋電容 ($V_{CB}=10\text{v}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$)	C_{re}	—	0.55	1.0	pF

1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.

2SC3356

■ DIMENSION 外形封裝尺寸



代碼	範圍 (單位: mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [FOSAN manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [TN6717A](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#)